

課題番号 : F-16-FA-0030
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : シリコンエッチング
Program Title (English) : Silicon etching
利用者名(日本語) : 岩尾勝彰¹⁾, 賀来伸一²⁾
Username (English) : K.Iwao¹⁾, S.Kaku²⁾
所属名(日本語) : 株式会社九州セミコンダクターKAW
Affiliation (English) : Kyushu Semiconductor KAW Co., Ltd.

1. 概要(Summary)

弊社でシリコンウェハーへのフォトリソ加工を行った後、FAIS 共同研究開発センターのリアクティブイオンエッチャーを利用しエッチング評価を実施する。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

リアクティブイオンエッチャー, 電子顕微鏡

【実験方法】

FAIS 共同研究開発センターのリアクティブイオンエッチャー(Fig.1)のエッチング条件を変更し, 電子顕微鏡にてドライエッチングの形状評価を実施する。

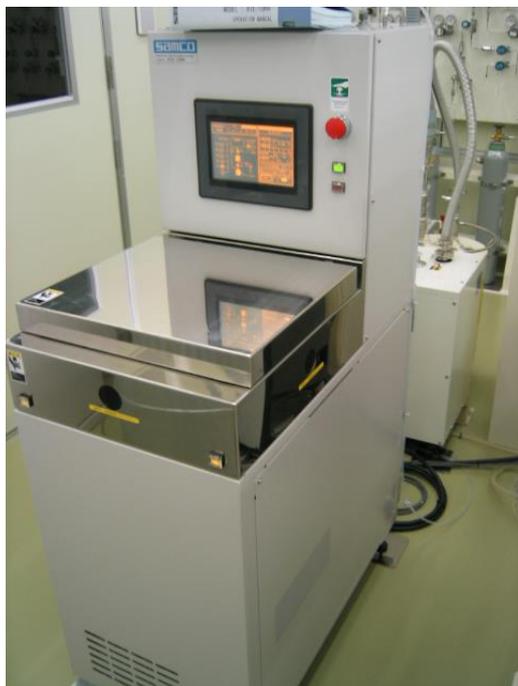


Fig.1 Reactive Ion Etcher

3. 結果と考察(Results and Discussion)

FAIS 共同研究開発センターと弊社の電子顕微鏡にて確認したところ, エッチング条件によりエッチング形状が変化することが確認できた。(形状等の評価詳細は弊社都合により割愛させて頂く)。

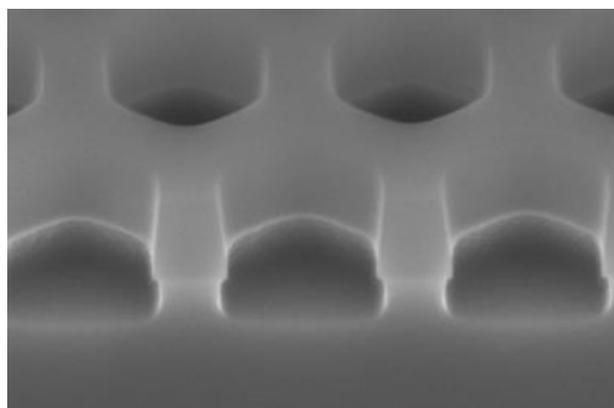


Fig.2 Etching of Silicon Wafer

4. その他・特記事項(Others)

無し

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

無し

6. 関連特許(Patent)

無し